

## Сведения о ведущей организации

1.	Полное наименование организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук
2.	Сокращенное наименование организации	ИПТМ РАН
3.	Ведомственная принадлежность	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
4.	Место нахождения	142432, г. Черноголовка, Московская область, ул. Академика Осипьяна, д.6
5.	Почтовый адрес организации с указанием индекса	142432, г. Черноголовка, Московская область, ул. Академика Осипьяна, д.6
6.	Телефон с указанием кода города	+7(496)524-4060
7.	Адрес электронной почты	general@iptm.ru
8.	Адрес официального сайта в сети «Интернет»	<a href="http://www.iptm.ru/">http://www.iptm.ru/</a>
9.	Руководитель организации	Рощупкин Дмитрий Валентинович
10.	Уполномоченный	
11.	Должность	Директор
12.	Ученая степень	Доктор физико-математических наук
13.	Ученое звание	Член-корреспондент Российской академии наук
14.	Список основных публикаций работников ведущей организации по тематике диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)	<p>1. Artemii Irzhak, Dmitrii Irzhak, Vladimir Khvostikov, Kirill Pundikov, Dmitrii Roshchupkin, Rashid Fahrtdinov, Effect of local changes in the composition of the <math>\text{LiNb}_{1-x}\text{Ta}_x\text{O}_3</math> single crystal on the Raman spectra, J Raman Spectrosc. 2022; 53: 969–976. DOI: <a href="https://doi.org/10.1002/jrs.6313">https://doi.org/10.1002/jrs.6313</a>, Q1</p> <p>2. Mololkin A.A., Roshchupkin D.V., Emelin E.E., Fahrtdinov R.R. Properties of high-temperature poling ferroelectric crystals congruent solid solution <math>\text{LiNb}_{0.5}\text{Ta}_{0.5}\text{O}_3</math>. <i>Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Materialy Elektronnoi Tekhniki = Materials of Electronics Engineering</i> 2021;24(1):34-39. (In Russ.) <a href="https://doi.org/10.17073/1609-3577-2021-1-34-39">https://doi.org/10.17073/1609-3577-2021-1-34-39</a></p> <p>3. Yuriy Suhak, Dmitry Roshchupkin, Boris Redkin, Ahsanul Kabir, Bujar Jerliu, Steffen Ganschow and Holger Fritze, Correlation of Electrical Properties and Acoustic Loss in Single Crystalline Lithium Niobate-Tantalate Solid Solutions at Elevated Temperatures, Crystals 2021, 11, 398. Q2, IF=2.404 <a href="https://doi.org/10.3390/cryst11040398">https://doi.org/10.3390/cryst11040398</a></p> <p>4. Dmitry Roshchupkin, Evgenii Emelin, Olga Plotitsyna, Fahrtdinov Rashid, Dmitry Irzhak, Vasilii Karandashev, Tatiana Orlova, Natalya Targonskaya, Sergey Sakharov, Anatolii Mololkin, Boris Redkin, Holger Fritze, Yuri Suhak, Dmitry Kovalev, Simone Vadilonga, Luc Ortega and Wolfram Leitenberger, Single crystals of ferroelectric lithium niobate–tantalate <math>\text{LiNb}_{1-x}\text{Ta}_x\text{O}_3</math> solid solutions for high-</p>

	<p>temperature sensor and actuator applications, Acta Cryst. (2020). <b>B76</b>, 1071–1076, <a href="https://doi.org/10.1107/S2052520620014390">https://doi.org/10.1107/S2052520620014390</a></p> <p>5. D.V. Roshchupkin<sup>1</sup>, E.V. Emelin, O.A. Plotitsyna, R.R. Fahrtdinov, D.V. Irzhak, V.K. Karandashev, T.V. Orlova, B.S. Redkin, H. Fritze, Yu. Suhak, Advanced Ferroelectric <math>\text{LiNb}_{(1-x)}\text{Ta}_x\text{O}_3</math> Crystal: Crystal Growth, Crystal Structure, Physical Properties, Armenian Journal of Physics, 2020, vol. <b>13</b>, issue 3, pp. 235-242</p> <p>6. Dmitry Roshchupkin, Luc Ortega, Simone Vadilonga, Ivo Zizak, Eugenii Emelin, Olga Plotitsyna, Dominique Thiaudie`re, Wolfram Leitenberger, Vincenzo Formoso, and Farid Fettar, X-ray diffraction on <math>\text{La}_3\text{Ga}_5\text{SiO}_{14}</math> crystal modulated by SAW near the K absorption edge of Ga, Appl. Phys. Lett. <b>116</b>, 174101 (2020); doi: 10.1063/5.0002388</p> <p>7. A.N. Redkin, E.E. Yakimov, D.V. Roshchupkin, V.I. Korepanov, Characterization of highly textured piezoelectric AlN films obtained from aluminum and ammonium chloride by a simple vapor deposition process, Thin Solid Films <b>684</b> (2019) 15–20, <a href="https://doi.org/10.1016/j.tsf.2019.05.049">https://doi.org/10.1016/j.tsf.2019.05.049</a></p> <p>8. Im Taek Yoon, Hak Dong Cho, Dmitry V. Roshchupkin, and Sejoon Lee, Enhanced structural and magnetic properties of carbon-assisted ZnO nanorod arrays on (100) Si substrate, Mater. Express, Vol. <b>8</b>, No. 1, 2018, p. 68-76, doi:10.1166/mex.2018.1412</p> <p>9. IM TAEK YOON, HAK DONG CHO, SEJOON LEE, and DMITRY V. ROSHCHUPKIN, Enhanced Structural and Luminescent Properties of CarbonAssisted ZnO Nanorod Arrays on (100) Si Substrate, Journal of ELECTRONIC MATERIALS, Vol. <b>47</b>, No. 8, 2018 <a href="https://doi.org/10.1007/s11664-018-6106-z">https://doi.org/10.1007/s11664-018-6106-z</a></p> <p>10. D. Irzhak and D. Roshchupkin, Measurement of independent piezoelectric moduli of <math>\text{Ca}_3\text{NbGa}_3\text{Si}_2\text{O}_{14}</math>, <math>\text{La}_3\text{Ga}_{5.5}\text{Ta}_{0.5}\text{O}_{14}</math> and <math>\text{La}_3\text{Ga}_5\text{SiO}_{14}</math> single crystals, J. Appl. Cryst. (2018). <b>51</b>, 1174–1181, <a href="https://doi.org/10.1107/S1600576718009184">https://doi.org/10.1107/S1600576718009184</a></p>
--	---

Директор ИПТМ РАН,  
член-корреспондент РАН,  
док. физ.-мат. наук



Д.В. Рошчупкин